

To all our customers

Regarding the change of names mentioned in the document, such as Mitsubishi Electric and Mitsubishi XX, to Renesas Technology Corp.

The semiconductor operations of Hitachi and Mitsubishi Electric were transferred to Renesas Technology Corporation on April 1st 2003. These operations include microcomputer, logic, analog and discrete devices, and memory chips other than DRAMs (flash memory, SRAMs etc.) Accordingly, although Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Semiconductors, and other Mitsubishi brand names are mentioned in the document, these names have in fact all been changed to Renesas Technology Corp. Thank you for your understanding. Except for our corporate trademark, logo and corporate statement, no changes whatsoever have been made to the contents of the document, and these changes do not constitute any alteration to the contents of the document itself.

Note : Mitsubishi Electric will continue the business operations of high frequency & optical devices and power devices.

Renesas Technology Corp.
Customer Support Dept.
April 1, 2003

FK20UM-5

HIGH-SPEED SWITCHING USE

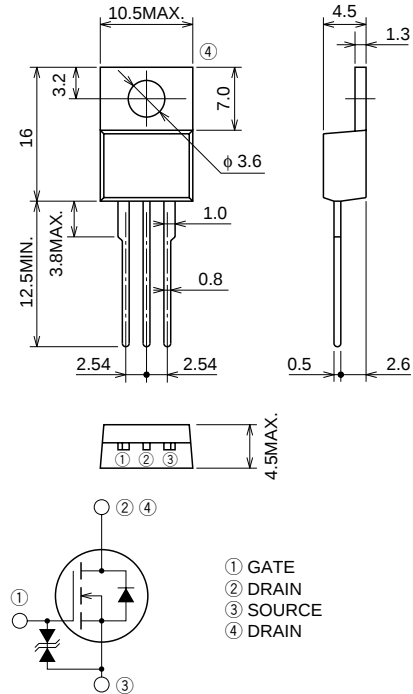
FK20UM-5



- V_{DS} 250V
- $r_{DS(ON)}$ (MAX) 0.24Ω
- I_D 20A
- Integrated Fast Recovery Diode (MAX.) 150ns

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



TO-220

APPLICATION

Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc.

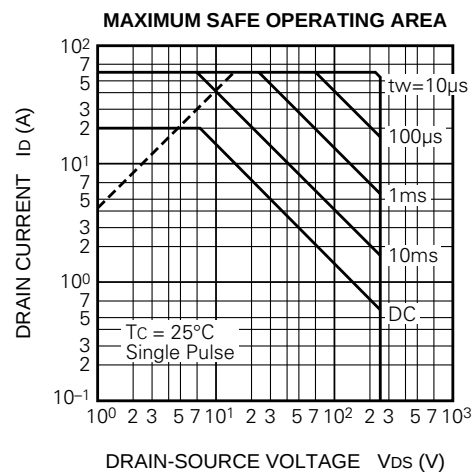
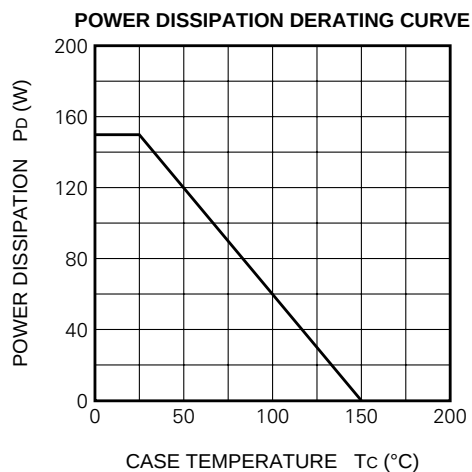
MAXIMUM RATINGS (Tc = 25°C)

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V_{DS}	Drain-source voltage	$V_{GS} = 0V$	250	V
V_{GSS}	Gate-source voltage	$V_{DS} = 0V$	± 30	V
I_D	Drain current		20	A
I_{DM}	Drain current (Pulsed)		60	A
I_S	Source current		20	A
I_{SM}	Source current (Pulsed)		60	A
P_D	Maximum power dissipation		150	W
T_{ch}	Channel temperature		$-55 \sim +150$	°C
T_{stg}	Storage temperature		$-55 \sim +150$	°C
—	Weight	Typical value	2.0	g

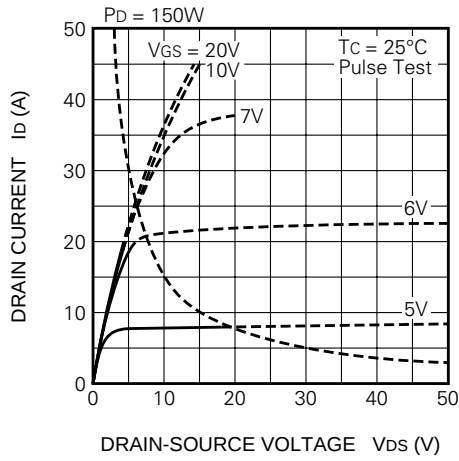
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{ch} = 25°C)

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
V (BR) DSS	Drain-source breakdown voltage	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	250	—	—	V
V (BR) GSS	Gate-source breakdown voltage	I _G = ±100μA, V _{DS} = 0V	±30	—	—	V
I _{GSS}	Gate-source leakage current	V _{GS} = ±25V, V _{DS} = 0V	—	—	±10	μA
I _{DSS}	Drain-source leakage current	V _{DS} = 250V, V _{GS} = 0V	—	—	1	mA
V _{GS} (th)	Gate-source threshold voltage	I _D = 1mA, V _{DS} = 10V	2	3	4	V
r _{DS} (ON)	Drain-source on-state resistance	I _D = 10A, V _{GS} = 10V	—	0.19	0.24	Ω
V _{DS} (ON)	Drain-source on-state voltage	I _D = 10A, V _{GS} = 10V	—	1.9	2.4	V
y _{fs}	Forward transfer admittance	I _D = 10A, V _{DS} = 10V	8.5	13.0	—	S
C _{iss}	Input capacitance	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	1400	—	pF
C _{oss}	Output capacitance		—	280	—	pF
C _{rss}	Reverse transfer capacitance		—	55	—	pF
t _d (on)	Turn-on delay time	V _{DD} = 150V, I _D = 10A, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = R _{GS} = 50Ω	—	25	—	ns
t _r	Rise time		—	50	—	ns
t _d (off)	Turn-off delay time		—	150	—	ns
t _f	Fall time		—	65	—	ns
V _{SD}	Source-drain voltage	I _S = 10A, V _{GS} = 0V	—	1.5	2.0	V
R _{th} (ch-c)	Thermal resistance	Channel to case	—	—	0.83	°C/W
t _{rr}	Reverse recovery time	I _S = 20A, di _s /dt = -100A/μs	—	—	150	ns

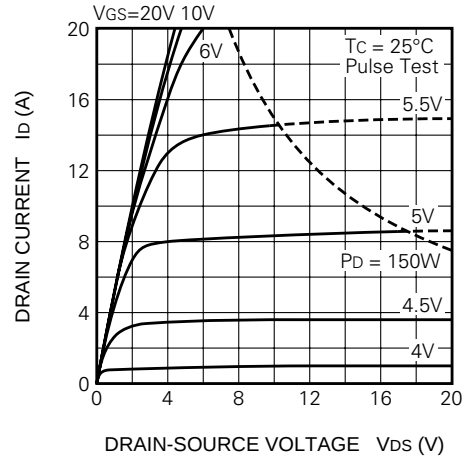
PERFORMANCE CURVES



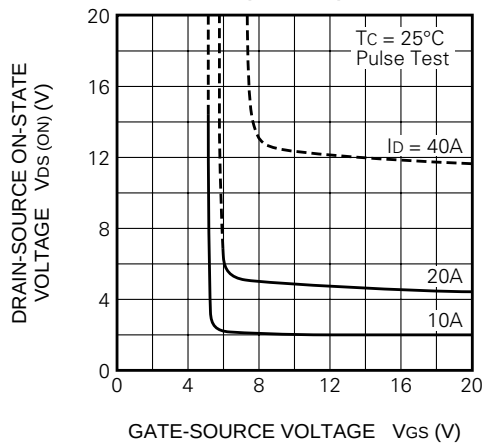
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



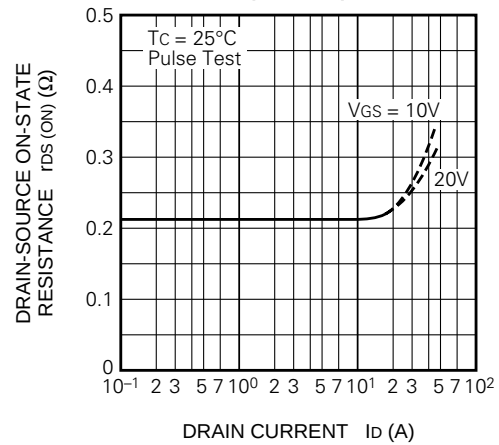
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



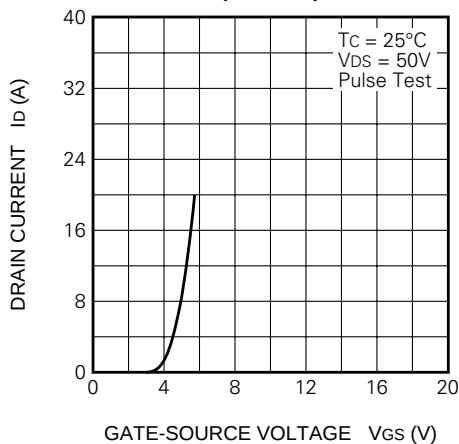
ON-STATE VOLTAGE VS.
GATE-SOURCE VOLTAGE
(TYPICAL)



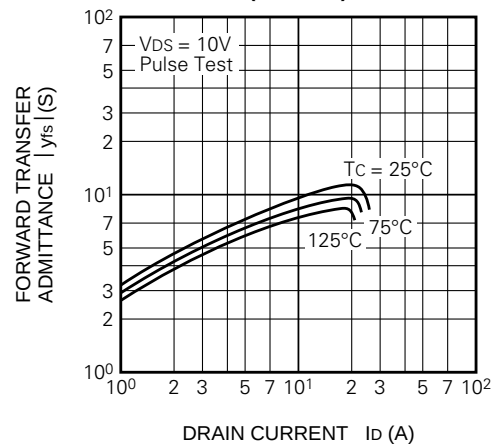
ON-STATE RESISTANCE VS.
DRAIN CURRENT
(TYPICAL)

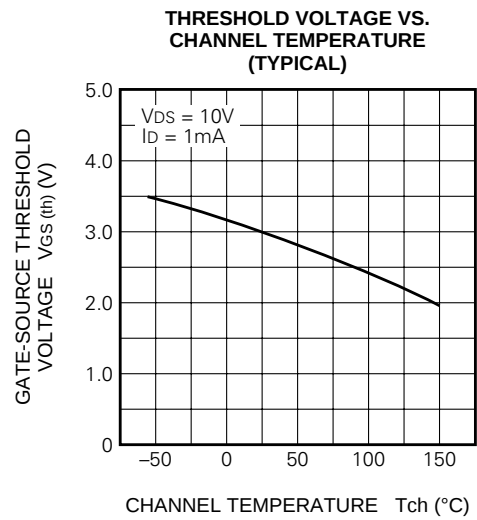
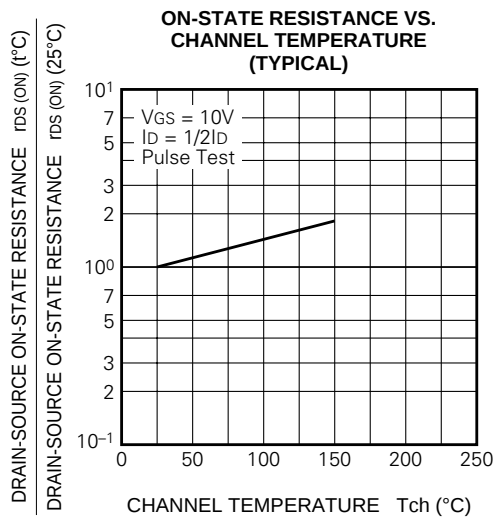
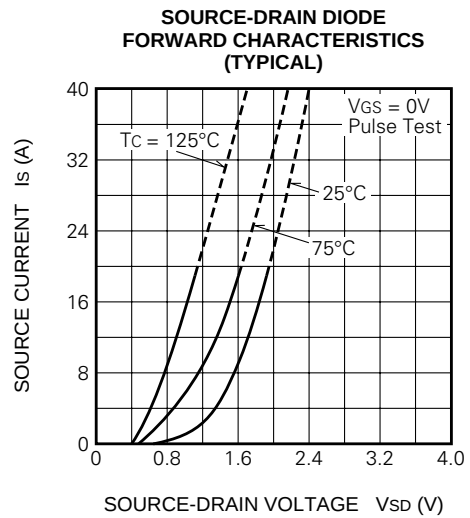
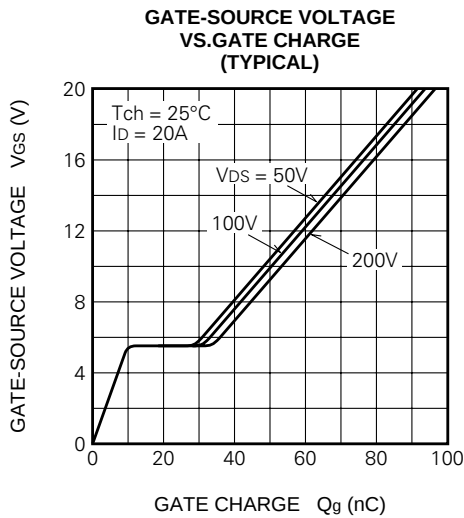
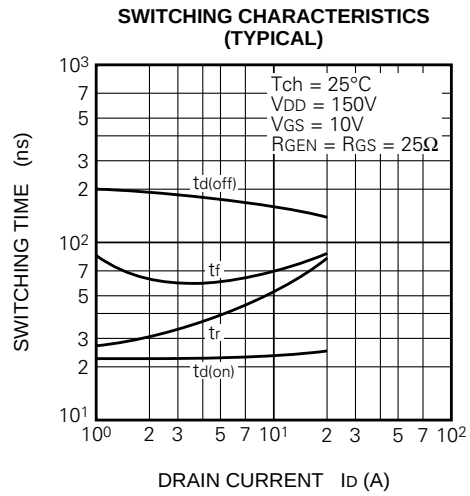
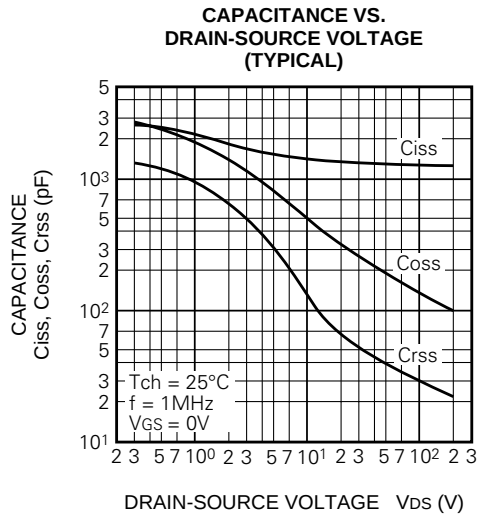


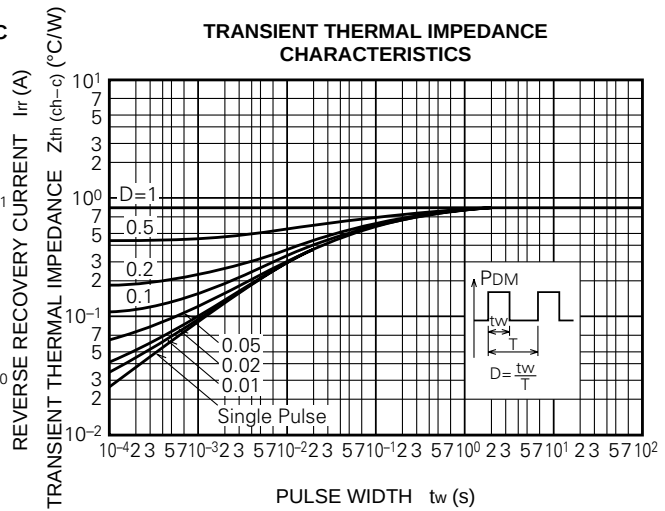
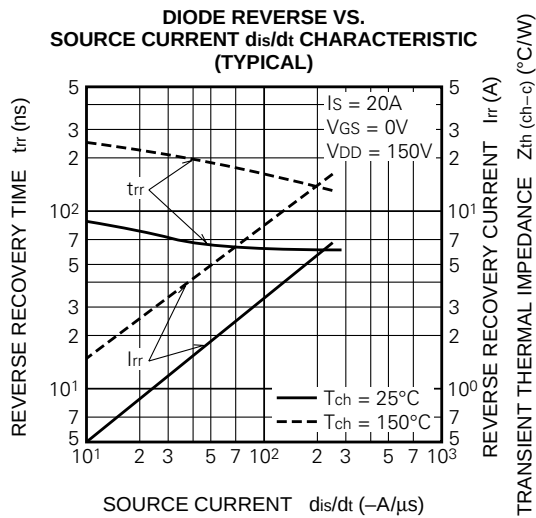
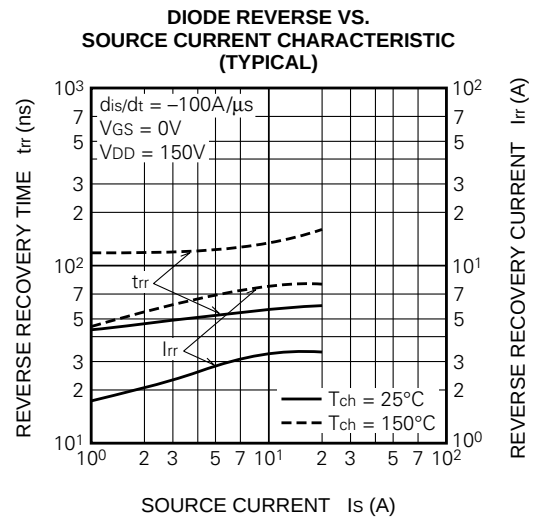
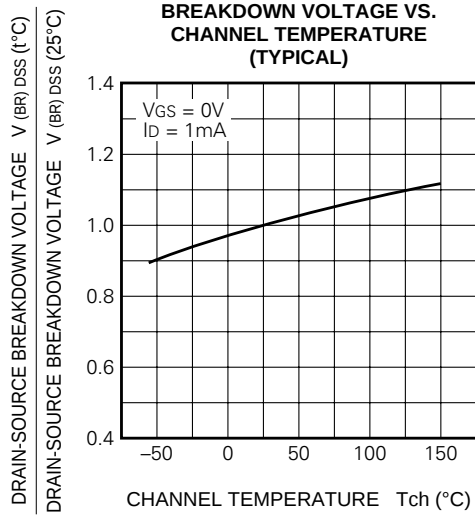
TRANSFER CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



FORWARD TRANSFER ADMITTANCE
VS.DRAIN CURRENT
(TYPICAL)









О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>